(11)特許出願公開番号

(12)公開特許公報(A)

(19) 日本国特許庁(JP)

特開2015-122459

(P2015-122459A)

(43) 公開日 平成27年7月2日(2015.7.2)

(51) Int.Cl.		FΙ			テーマコード (参考)
HO1L 51/50	(2006.01)	HO5B	33/22	D	3 K 1 O 7
COTD 209/88	(2006.01)	HO5B	33/14	В	4C2O4
CO7D 209/86	(2006.01)	C O 7 D	209/88		
		C O 7 D	209/86		

審査請求 未請求 請求項の数 12 OL (全 21 頁)

(21) 出願番号	特願2013-266552 (P2013-266552)	(71) 出願人	512187343
(22) 出願日	平成25年12月25日 (2013.12.25)		三星ディスプレイ株式會社
			Samsung Display Co.
			, Ltd.
			大韓民国京畿道龍仁市器興区三星二路95
			95, Samsung 2 Ro, Gih
			eung-Gu, Yongin-City
			, Gyeonggi-Do, Korea
		(74)代理人	110000981
			アイ・ピー・ディー国際特許業務法人
		(72)発明者	佐藤 朱里
			神奈川県横浜市鶴見区菅沢町2-7 株式
			会社サムスン日本研究所内
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】有機EL素子

(57)【要約】

【課題】駆動電圧の増加を抑制しつつ、発光効率を更に 向上させることが可能な、有機 E L 素子を提供すること

【解決手段】本発明に係る有機EL素子は、陽極と、前 記陽極上に設けられ、互いに異なる化合物を主成分とす る複数層からなる正孔輸送層と、前記正孔輸送層上に設 けられる発光層と、前記発光層上に設けられる陰極と、 を備え、前記複数層からなる正孔輸送層のうち最も厚み が厚い第1の正孔輸送層における正孔移動度が、当該第 1の正孔輸送層と前記発光層との間に位置する前記正孔 輸送層のうち少なくとも1層における正孔移動度よりも 大きい。

【選択図】図1



【特許請求の範囲】

【請求項1】

陽極と、

前記陽極上に設けられ、互いに異なる化合物を主成分とする複数層からなる正孔輸送層 と、

前記正孔輸送層上に設けられる発光層と、 前記発光層上に設けられる陰極と、

を備え、

前記複数層からなる正孔輸送層のうち最も厚みが厚い第1の正孔輸送層における正孔移 10 動度が、当該第1の正孔輸送層と前記発光層との間に位置する前記正孔輸送層のうち少な くとも1層における正孔移動度よりも大きい、有機 EL素子。

【請求項2】

前記第1の正孔輸送層の正孔移動度は、0.3MV/cm~1.0MV/cmの電界の 範囲において、1×10⁻⁴~1×10⁻³cm²/V・secであり、

前記第1の正孔輸送層と前記発光層との間に位置する前記正孔輸送層のうち少なくとも 1 層の正孔移動度が、0.3 M V / c m ~ 1.0 M V / c m の電界の範囲において、1 × 10⁻⁵~1×10⁻⁴ cm²/V・secである、請求項1に記載の有機EL素子。

【請求項3】

前記第1の正孔輸送層と発光層との間に位置する正孔輸送層のうち少なくとも1層の厚 20 みは、前記第1の正孔輸送層の厚みの1/10以下である、請求項1又は2に記載の有機 EL素子。

【請求項4】

前記第1の正孔輸送層と発光層との間に位置する正孔輸送層のうち少なくとも1層の主 成分が、アミノカルバゾール誘導体である、請求項1~3の何れか1項に記載の有機EL 素子。

【請求項5】

前記アミノカルバゾール誘導体は、下記一般式(1a)又は一般式(1b)で表される 化合物である、請求項4に記載の有機EL素子。 【化1】

30

40





Ar₁~Ar₇は、置換もしくは無置換のアリール基、又は、置換もしくは無置換のヘ テロアリール基であり、L₁~L₂は、結合基、置換もしくは無置換のアリーレン基、又 は、置換もしくは無置換のヘテロアリーレン基である。 【請求項 6】

前記第1の正孔輸送層と発光層との間に位置する正孔輸送層のうち少なくとも1層の主 成分が、モノアミン誘導体である、請求項1~3の何れか1項に記載の有機EL素子。 【請求項7】

前記モノアミン誘導体は、下記一般式(2)で表される化合物である、請求項6に記載の有機 EL素子。

10

20



 $\cdot \cdot \cdot (2)$

ここで、上記一般式(2)において、

R₁、R₂及びR₃は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、置換もしくは無置換の炭素数1~15のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数6~30のアリール基、

又は、置換もしくは無置換の炭素数1~30のヘテロアリール基であり、 1、m、nは、それぞれ0 1 4、0 m 4、0 n 5、を満たす整数であり、

A r _{1 1} は、置換又は無置換の炭素数 6 ~ 3 0 のアリール基であり、

R₁₁は、水素原子、フッ素原子、置換シリル基であり、

oは、0 o 3を満たす整数である。

ただし、oが2以上のとき、R₁₁は上記の中で異なっていてもよい。

【請求項8】

前記第1の正孔輸送層と発光層との間に位置する正孔輸送層のうち少なくとも1層の主 成分が、カルバゾール誘導体である、請求項1~3の何れか1項に記載の有機EL素子。 【請求項9】

前 記 カ ル バ ゾ ー ル 誘 導 体 は 、 下 記 一 般 式 (3) で 表 さ れ る 化 合 物 で あ る 、 請 求 項 8 に 記 載 の 有 機 E L 素 子 。

【化3】



ここで、上記一般式(3)において、

30

(4)

Ar1は、炭素数6~30のアリール基、炭素数1~30のヘテロアリール基、又は、 炭素数1~15のアルキル基であり、 R 1 ~ R 1 7 は、炭素数 6 ~ 3 0 のアリール基、炭素数 1 ~ 3 0 のヘテロアリール基、 炭 素 数 1 ~ 1 5 の ア ル キ ル 基 、 ア ル コ キ シ 基 、 八 ロ ゲ ン 原 子 、 水 素 原 子 、 又 は 、 重 水 素 原 子であり、 Ar。は、炭素数 6~30の窒素、酸素、硫黄、リン、ケイ素からなる群より選択され るヘテロ原子を含んでもよい縮合環、又は、炭素と窒素とからなる縮合環であり、 Ar₁及びAr₂は、互いに異なる置換基であり、 a 及びb は、0~3 であり、 10 L 」 及び L 。は、単結合又は 2 価の連結基を表し、 隣接した複数のR₁ ~ R₁₀は結合し、飽和又は不飽和の環を形成してもよい(ただし 、R.とR。、又は、RっとR.。が結合し、芳香環を形成することはない)。 【請求項10】 前記発光層は、青色蛍光発光材料を含む、請求項1~9の何れか1項に記載の有機EL 素子。 【請求項11】 前記発光層は、赤色リン光発光材料を含む、請求項1~9の何れか1項に記載の有機E L素子。 【請求項12】 20 前記発光層は、緑色リン光発光材料を含む、請求項1~9の何れか1項に記載の有機E L素子。 【発明の詳細な説明】 【技術分野】 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 本発明は、有機EL素子に関する。 【背景技術】 [0002]近年、発光材料を表示部の発光素子に用いた有機エレクトロルミネッセンス表示装置(30 Organic Electroluminescence Display:有機EL 表示装置)の開発が盛んになってきている。有機EL表示装置は、液晶表示装置等とは異 なり、陽極及び陰極から注入された正孔及び電子を発光層において再結合させることによ り、発光層における有機化合物を含む発光材料を発光させて表示を実現する、いわゆる自 発光型の表示装置である。 [0003]近年、有機エレクトロルミネッセンス素子(以下、有機EL素子という。)として、発 光層、及び、この発光層にキャリア(carrier)である正孔や電子を輸送する層等 のように、特性の異なる複数の層で構成されたものが提案されている。 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ 40 有機EL素子の発光効率を向上させるためには、発光層において正孔と電子とが再結合 する確率を増やすことが重要である。正孔と電子のどちらかが過剰に供給され、再結合し ないまま各電荷が発光層を通過してしまうと、発光効率が低下してしまう。そのため、こ の電子と正孔の注入バランス(balance)は、有機EL素子の発光効率及び寿命を

決定する要因として、極めて重要な因子であると言える。

【 0 0 0 5 】

上記のような電子と正孔の注入バランスを制御するために、有機EL素子を構成する複数の層の電荷移動度を制御する試みがなされている。例えば、下記の特許文献1には、1層のみからなる正孔輸送層の正孔移動度を、所定の範囲内とする技術が開示されている。 【先行技術文献】 【特許文献】

20

30

[0006]

【特許文献1】特開2008-130840号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

[0007]

しかしながら、上記特許文献1に開示されているように、1層のみからなる正孔輸送層の正孔移動度を制御する場合には、有機EL素子の駆動電圧が増加してしまうという問題があった。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$

そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ ¹⁰ は、駆動電圧の増加を抑制しつつ、発光効率を更に向上させることが可能な、有機EL素 子を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0009】

上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、陽極と、前記陽極上に設けられ、互いに異なる化合物を主成分とする複数層からなる正孔輸送層と、前記正孔輸送層上に設けられる発光層と、前記発光層上に設けられる陰極と、を備え、前記複数層からなる正孔輸送層のうち最も厚みが厚い第1の正孔輸送層における正孔移動度が、当該第1の正 孔輸送層と前記発光層との間に位置する前記正孔輸送層のうち少なくとも1層における正 孔移動度よりも大きい有機 EL素子が提供される。

[0010]

かかる有機 EL素子の正孔輸送層では、互いに異なる正孔移動度を有する化合物からなる正孔輸送層を複数層設けることで、正孔移動度のバランスを取ることができ、駆動電圧の増加を抑制しつつ、発光効率を更に向上させることが可能となる。

[0011**]**

前記第1の正孔輸送層の正孔移動度は、0.3 M V / c m ~ 1.0 M V / c m の電界の 範囲において、1 × 1 0⁻⁴ ~ 1 × 1 0⁻³ c m² / V · s e c であり、前記第1の正孔 輸送層と前記発光層との間に位置する前記正孔輸送層のうち少なくとも1層の正孔移動度 が、0.3 M V / c m ~ 1.0 M V / c m の電界の範囲において、1 × 1 0⁻⁵ ~ 1 × 1 0⁻⁴ c m² / V · s e c であることが好ましい。

【0012】

第1の正孔輸送層、及び、第1の正孔輸送層と発光層との間に位置する正孔輸送層のう ち少なくとも1層の正孔移動度が上記の範囲となることで、正孔移動度のバランスを取る ことができ、駆動電圧の増加を抑制しつつ、発光効率を更に向上させることが可能となる

[0013]

前記第1の正孔輸送層と発光層との間に位置する正孔輸送層のうち少なくとも1層の厚みは、前記第1の正孔輸送層の厚みの1/10以下であることが好ましい。

【0014】

前記第1の正孔輸送層と発光層との間に位置する正孔輸送層のうち少なくとも1層の厚 40 みを上記のようにすることで、駆動電圧の増加を抑制しつつ、発光効率を更に向上させる ことが可能となる。

【 0 0 1 5 】

前記第1の正孔輸送層と発光層との間に位置する正孔輸送層のうち少なくとも1層の主 成分が、アミノカルバゾール誘導体であってもよい。

[0016]

前記アミノカルバゾール誘導体は、下記一般式(1 a)又は一般式(1 b)で表される 化合物であることが好ましい。

【 0 0 1 7 】

【化1】



•••(1a)



【0018】

ここで、上記一般式(1 a)及び(1 b)において、 A r 1 ~ A r 7 は、置換もしくは 無置換のアリール基、又は、置換もしくは無置換のヘテロアリール基であり、 L 1 ~ L 2 は、結合基、置換もしくは無置換のアリーレン基、又は、置換もしくは無置換のヘテロア リーレン基である。

[0019]

前記第1の正孔輸送層と発光層との間に位置する正孔輸送層のうち少なくとも1層の主 成分が、モノアミン誘導体であってもよい。

[0020]

前記モノアミン誘導体は、下記一般式(2)で表される化合物であることが好ましい。 30 【0021】

【化2】



•••(2)

[0022]

ここで、上記一般式(2)において、R₁、R₂及びR₃は、それぞれ独立に、水素原 子、ハロゲン原子、置換もしくは無置換の炭素数1~15のアルキル基、置換もしくは無 置換の炭素数6~30のアリール基、又は、置換もしくは無置換の炭素数1~30のヘテ ロアリール基であり、1、m、nは、それぞれ0 1 4、0 m 4、0 n 5、を 満たす整数であり、Ar₁ は、置換又は無置換の炭素数6~30のアリール基であり、 R₁ は、水素原子、フッ素原子、置換シリル基であり、oは、0 o 3を満たす整数 である。ただし、oが2以上のとき、R₁ は上記の中で異なっていてもよい。 10

[0023]

前記第1の正孔輸送層と発光層との間に位置する正孔輸送層のうち少なくとも1層の主 成分が、カルバゾール誘導体であってもよい。

【 0 0 2 4 】

前記カルバゾール誘導体は、下記一般式(3)で表される化合物であることが好ましい

- [0025]
- 【化3】



· · · (3)

[0026]

ここで、上記一般式(3)において、Ar₁は、炭素数6~30のアリール基、炭素数 20 1~30のヘテロアリール基、又は、炭素数1~15のアルキル基であり、R₁~R₁₇ は、炭素数6~30のアリール基、炭素数1~30のヘテロアリール基、炭素数1~15 のアルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子、水素原子、又は、重水素原子であり、Ar 2 は、炭素数6~30の窒素、酸素、硫黄、リン、ケイ素からなる群より選択されるヘテ ロ原子を含んでもよい縮合環、又は、炭素と窒素とからなる縮合環であり、Ar₁及びA r₂は、互いに異なる置換基であり、a及びbは、0~3であり、L₁及びL₂は、単結 合又は2価の連結基を表し、隣接した複数のR₁~R₁₀は結合し、飽和又は不飽和の環 を形成してもよい(ただし、R₁とR₆、又は、R₂とR₁₀が結合し、芳香環を形成す ることはない)。

【0027】

前記第1の正孔輸送層と発光層との間に位置する正孔輸送層のうち少なくとも1層の主 成分を、上記のような3種類の誘導体の何れかとすることで、駆動電圧の増加を抑制しつ つ、発光効率を更に向上させることが可能となる。

[0028]

前記発光層は、青色蛍光発光材料を含んでもよい。また、前記発光層は、赤色リン光発 光材料を含んでもよい。また、前記発光層は、緑色リン光発光材料を含んでもよい。 【発明の効果】

【0029】

以上説明したように本発明によれば、第1の正孔輸送層、及び、第1の正孔輸送層と発 光層との間に位置する正孔輸送層のうち少なくとも1層の正孔移動度を所定の範囲とする ことで、有機EL素子の駆動電圧の増加を抑制しつつ、発光効率を更に向上させることが 可能となる。

【図面の簡単な説明】

[0030]

【図1】本発明の実施形態に係る有機EL素子の一例を示す概略断面図である。

【図2】本発明の実施形態に係る有機 EL素子が備える正孔輸送層の一例を示す概略断面 図である。

【図3】本発明の実施形態に係る有機EL材料を使用して製造した有機EL素子の概略断 面図である。 10

【発明を実施するための形態】

【0031】

以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。 なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については 、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。

【0032】

(有機 E L 素子の構成について)

まず、図1及び図2を参照しながら、本発明の実施形態に係る有機EL素子100の構成について、詳細に説明する。図1は、本実施形態に係る有機EL素子の一例を示す概略断面図であり、図2は、本実施形態に係る有機EL素子が備える電子輸送層の一例を示す概略断面図である。

【0033】

本実施形態に係る有機EL素子は、例えば、図1に示すような構造を有している。なお、図1に示した有機EL素子の構造はあくまでも一例であって、本実施形態に係る有機EL素子が図1に示した構造に限定されるものではない。

[0034]

なお、以下では、「A層上に設けられたB層」という表現を用いるが、かかる表現におけるA層とB層との関係は、A層の直上にB層が存在する場合に限定されるものではなく、A層の上方にB層が存在する場合も含むものとする。すなわち、かかる表現は、A層の 直上に1又は複数の層が存在し、これらの層の直上にB層が存在する場合も含むものとす る。

20

10

[0035]

[有機 E L 素子の全体構成について]

本実施形態に係る有機EL発光素子100は、図1に示したように、基板102と、基 板102上に配置された第1電極104と、第1電極104上に配置された正孔注入層1 06と、正孔注入層106上に配置された正孔輸送層108と、正孔輸送層108上に配 置された発光層110と、発光層110上に配置された電子輸送層112と、電子輸送層 112上に配置された電子注入層114と、第2電極116と、を備える。 【0036】

基板102は、一般的な有機EL素子で使用される基板を使用することができる。例え ³⁰ ば、基板102は、ガラス(glass)基板、半導体基板、または透明なプラスチック (plastic)基板等であってもよい。

[0037]

第1電極104は、例えば、アノード(陽極)であり、蒸着法、スパッタリング(sputter ing)法又は塗布法などを用いて基板102上に形成される。具体的には、 第1電極104は、仕事関数が大きい金属、合金、導電性化合物等によって透過型電極と して形成される。第1電極104は、例えば、透明であり、導電性にすぐれる酸化インジ ウムスズ(ITO)、酸化インジウム亜鉛(IZO)、酸化スズ(SnO₂)、酸化亜鉛 (ZnO)などで形成されてもよい。また、第1電極104は、マグネシウム(Mg)、 アルミニウム(A1)などを用いて反射型電極として形成されてもよい。 【0038】

正孔注入層106は、第1電極104からの正孔の注入を容易にする機能を備えた層で あり、必要に応じて、第1電極104上に形成される。この正孔注入層106は、真空蒸 着法、スピンコーティング法、インクジェット法などを用いて第1電極104上に形成さ れる。また、正孔注入層106は、具体的には、約0.1nm~約1000nm、より具 体的には、約1nm~約100nmの厚さにて形成されてもよい。 【0039】

なお、正孔注入層106は、例えば、N,N' - ジフェニル - N,N' - ビス - [4 -(フェニル - m - トリル - アミノ) - フェニル] - ビフェニル - 4,4' - ジアミン(D NTPD)、銅フタロシアニンなどのフタロシアニン化合物、4,4' , 4" - トリス(

3 - メチルフェニルフェニルアミノ)トリフェニルアミン(m - MTDATA)、N,N
· ジ(1 - ナフチル) - N,N' - ジフェニルベンジジン(NPB)、4,4',4"
- トリス {N,Nジフェニルアミノ}トリフェニルアミン(TDATA)、4,4',4
" - トリス(N,N - 2 - ナフチルフェニルアミノ)トリフェニルアミン(2 - TNAT
A)、ポリアニリン/ドデシルベンゼンスルホン酸(Pani/DBSA)、ポリ(3,4 - エチレンジオキシチオフェン)/ポリ(4 - スチレンスルホネート)(PEDOT/PSS)、ポリアニリン/カンファースルホン酸(Pani/CSA)、ポリアニリン/ポリ(4 - スチレンスルホネート)(PANI/PSS)又はヘキサアザトリフェニレン
ペキサカルボニトリル(HAT(CN)))などを用いて形成することができる。

正孔輸送層108は、主に正孔を輸送する機能を有する正孔輸送材料を含む層であり、 ホスト材料や発光ドーパント材料を主成分としない層である。すなわち、本実施形態に係 る正孔輸送層108自体は、有機EL素子の発光輝度に大きく寄与しない点に注意された い。正孔輸送層108は、電子阻止層及び/又は励起子閉じ込め層としての機能を有して もよい。

【0041】

この正孔輸送層108は、真空蒸着法、スピンコーティング法、インクジェット法など を用いて正孔注入層106上(場合によっては、第1電極104上)に形成される。本実 施形態に係る有機EL素子100は、互いに異なる化合物を主成分とする、複数の層から 構成されるが、この正孔輸送層108の詳細な構成については、以下で詳述する。 【0042】

発光層110は、蛍光やリン光等の光を発する層であり、真空蒸着法、スピンコーティング法、インクジェット法などを用いて正孔輸送層108上に形成される。また、発光層110は、ホスト(host)材料及び発光ドーパント(dopant)材料を含んでいてもよい。なお、発光層110は、具体的には、約10nm~約100nm、より具体的には、約20nm~約60nmの厚さで形成されてもよい。

【0043】

発光層110は、特定の色の光を発する発光層として形成されてもよい。例えば、発光 層110は、赤色発光層、緑色発光層、又は青色発光層として形成されてもよい。また、 複数色の発光ドーパントを用いて、白色発光層としてもよい。更に、異なる発光色を発す る発光層の積層構造により、白色発光層としてもよい。

【0044】

また、発光層110に用いるホスト材料としては、例えば、トリス(8-キノリノラト) アルミニウム(Alq₃)、4,4',4" - トリス(N - カルバゾリル)トリフェニ ルアミン(TCTA)、1,3,5 - トリス(N - フェニルベンズイミダゾール - 2 - イ ル)ベンゼン(TPBI)、ポリ(n - ビニルカルバゾール)(PVK)、9,10 - ジ (ナフタレン - 2 - イル)アントラセン(ADN)、3 - tert - ブチル - 9,10 -ジ(ナフト - 2 - イル)アントラセン(TBADN)、ジスチリルアリーレン(DSA) 、4,4' - N,N' - ジカバゾール - ビフェニル(CBP)、4,4' - ビス(9 - カ ルバゾール) - 2,2' - ジメチル - ビフェニル(dmCBP)を使用することができる

【0045】

発光層110に用いる青色ドーパントとしては、例えば、1,4 - ビス[2 - (3 - N - エチルカルバゾリル)ビニル]ベンゼン(BCzVB)、4 - (ジ-p-トルイルアミノ) - 4 ' - [(ジ - p - トルイルアミノ)スチリル]スチルベン(DPAVB)、N - (4 - ((E) - 2 - (6 - ((E) - 4 - (ジフェニルアミノ)スチリル)ナフタレン - 2 - イル)ビニル)フェニル) - N - フェニルベンゼンアミン(N - BDAVBi)などのスチリル誘導体、ペリレン(perlene)及びその誘導体(例えば、2,5,8,11 - テトラ - t - ブチルペリレン(TBPe))、ピレン及びその誘導体(例えば、1,1 - ジピレン、1,4 - ジピレニルベンゼン)、ビス[2 - (4,6 - ジフルオロフェ

10

30

ニル)ピリジネート]ピコリネートイリジウム(III)(FIrpic)などを使用す ることができる。

【0046】

また、発光層110に用いる赤色ドーパントとしては、例えば、5,6,11,12 テトラフェニルナフタセン(ルブレン(rubrene))、4-ジシアノメチレン-2 - (p-ジメチルアミノスチリル)-6-メチル-4H-ピラン(DCM)及びその誘導 体、ビス(1 フェニルイソキノリン)(アセチルアセトネート)イリジウム(III) (Ir(pia)₂(acac))などを使用することができる。 【0047】

また、発光層110に用いる緑色ドーパントとしては、例えば、3-(2-ベンゾチア ¹⁰ ゾリル)-7-(ジエチルアミノ)クマリン(クマリン6(coumarin6))、ト リス(2-フェニルピリジン)イリジウム(III)(Ir(ppy)₃)などを使用す ることができる。

【0048】

電子輸送層112は、主に電子を輸送する機能を有する電子輸送材料を含む層であり、 必要に応じて、発光層110上に形成される。この電子輸送層112は、正孔阻止層及び /又は励起子閉じ込め層としての機能を有してもよい。この電子輸送層112は、真空蒸 着法、スピンコーティング法、インクジェット法などを用いて形成される。また、電子輸 送層112は、具体的には、約10nm~約100nm、より具体的には、約15nm~ 約50nmの厚さにて形成されてもよい。なお、電子輸送層112は、例えば、リチウム キノレート(LiQ)、フッ化リチウム(LiF)などを用いて形成することができる。 【0049】

電子注入層114は、第2電極116からの電子の注入を容易にする機能を備えた層で あり、必要に応じて、電子輸送層112上(場合によっては、発光層110上)に形成さ れる。この電子注入層114は、真空蒸着法などを用いて形成される。また、電子注入層 114は、具体的には、約0.1nm~約10nm、より具体的には、約0.1nm~約 3nmの厚さにて形成されてもよい。なお、電子注入層114は、例えば、フッ化リチウ ム(LiF)、塩化ナトリウム(NaC1)、フッ化セシウム(CsF)、酸化リチウム (Li₂O)、酸化バリウム(BaO)などを用いて形成することができる。 【0050】

第2電極116は、例えば、カソード(陰極)であり、蒸着法またはスパッタリング法 などを用いて電子注入層114上に形成される。具体的には、第2電極116は、仕事関 数が小さい金属、合金、導電性化合物等で反射型電極として形成される。第2電極116 は、例えば、リチウム(Li)、マグネシウム(Mg)、アルミニウム(Al)、アルミ ニウム - リチウム(Al - Li)、カルシウム(Ca)、マグネシウム - インジウム(M g - In)、マグネシウム - 銀(Mg - Ag)などで形成されてもよい。また、第2電極 116は、酸化インジウムスズ(ITO)、酸化インジウム亜鉛(IZO)などを用いて 透過型電極として形成されてもよい。

【0051】

以上、図1を参照しながら、本実施形態に係る有機EL素子100の全体構成について ⁴⁰ 、簡単に説明した。

【 0 0 5 2 】

[正孔輸送層の構成について]

次に、図2を参照しながら、本実施形態に係る有機EL素子100が備える正孔輸送層 108の構成について、詳細に説明する。

[0053]

本実施形態に係る正孔輸送層108は、図2に模式的に示したように、複数の層から構成される。複数の層から構成される正孔輸送層108は、全ての層が互いに異なる化合物 を主成分としていてもよく、複数の層のうち一部の層が同一の化合物を主成分とする層で あってもよい。図2に示した例では、最も陽極側に位置する正孔輸送層151から、最も

発光層側に位置する正孔輸送層159まで、5つの層から構成される場合を図示している。しかしながら、正孔輸送層108を構成する層の数は、図2に示した例に限定されるも のではなく、2層以上であればよい。

【0054】

ここで、本実施形態に係る正孔輸送層108では、複数層からなる正孔輸送層108の うち、最も厚みが厚い層を、第1の正孔輸送層の一例である正孔輸送層Aとした場合に、 正孔輸送層Aにおける正孔移動度が、正孔輸送層Aと発光層110との間に位置する残り の正孔輸送層108のうち少なくとも1層における正孔移動度よりも大きくなっている。 【0055】

図2に示した例では、5つの層から構成される正孔輸送層108のうち、最も厚みが厚 い層は、正孔輸送層153である。従って、かかる場合には、正孔輸送層153が、上記 正孔輸送層Aとして取り扱われる。また、正孔輸送層153と発光層110との間に位置 する正孔輸送層は、正孔輸送層155~正孔輸送層159である。従って、正孔輸送層1 53の正孔移動度は、これら3つの正孔輸送層のうちの少なくとも1層における正孔移動 度よりも大きい値となっている。

【0056】

正孔輸送層108を構成する複数の層の正孔移動度が上記のように構成されることで、 正孔輸送層108のうち陽極に近い側(すなわち、正孔が入ってくる側)に正孔移動度の 大きな輸送層の厚膜を形成することとなり、発光層110に近い側に正孔移動度の小さな 輸送層を形成することとなる。その結果、正孔移動度の大きな輸送層の厚膜により、有機 EL素子の低駆動電圧化を保持しつつ、多くの正孔を発光層に注入することができ、有機 EL素子の高効率化を図ることが可能となる。このように、本実施形態に係る正孔輸送層 108は、正孔移動度の大きな(換言すれば、正孔輸送能の優れた)正孔輸送材料と、正 孔移動度の相対的に小さな(換言すれば、正孔輸送能がそれほど優れていない)正孔輸送 材料と、を意図的に組み合わせてバランス(balance)を取ることで、有機EL素 子の低駆動点圧下及び高効率化を実現する層である。

なお、以下では、説明の便宜上、「正孔輸送層Aと発光層110との間に位置する残りの正孔輸送層108のうち少なくとも1層」のことを、「正孔輸送層B」と略記する。

より詳細には、上記正孔輸送層 A の正孔移動度は、0.3 M V / c m ~ 1.0 M V / c m の電界の範囲において、1 × 1 0 ⁻⁴ ~ 1 × 1 0 ⁻³ c m ² / V ・ s e c であり、正孔 輸送層 B の正孔移動度が、0.3 M V / c m ~ 1.0 M V / c m の電界の範囲において、 1 × 1 0 ⁻⁵ ~ 1 × 1 0 ⁻⁴ c m ² / V ・ s e c であることが好ましい。正孔輸送層 A 及 び正孔輸送層 B の正孔移動度を上記の範囲とすることで、駆動電圧の増加を抑制しつつ、 発光効率を更に向上させることが可能となる。

【 0 0 5 9 】

ここで、正孔輸送層Aの厚みについては、特に限定されるものではないが、例えば、20nm~300nm程度とすることが好ましい。正孔輸送層Aの厚みが20nm未満である場合には、陽極 / 陰極電極間のリーク(1 e a k)が発生する可能性が高くなるため、好ましくない。また、正孔輸送層Aの厚みが300nm超過となる場合には、有機 E L 素子100の駆動電圧が高くなり消費電力の観点より好ましくない。 【0060】

また、正孔輸送層 B の厚みは、正孔輸送層 A の厚みの1 / 1 0 以下とすることが好まし い。正孔輸送層 B の厚みが正孔輸送層 A の厚みの1 / 1 0 以下となることで、正孔輸送度 が相対的に小さな輸送層の厚みを薄くすることが可能となり、正孔を正孔輸送層 1 0 8 と 発光層 1 1 0 との界面に集めて励起子密度を更に増加させて、より確実に素子の高効率化 を図ることが可能となる。なお、正孔輸送層 B の厚みは、小さければ小さいほど良いが、 膜形成の観点より、その厚みは、5 n m 以上とすることが好ましい。 【0061】 20

10

なお、正孔を正孔輸送層108と発光層110との界面に効率的に集めるという観点に おいて、正孔輸送層Bは、正孔輸送層Aと発光層110との間に位置する正孔輸送層であ れば良いが、正孔輸送層Aよりも正孔移動度の相対的に小さな正孔輸送層は、なるべく発 光層110側(より好ましくは、発光層110との界面を形成する位置)に設けることが 好ましい。例えば図2に示した例では、正孔輸送層159は、正孔輸送層Aを構成する化 合物よりも正孔移動度の相対的に小さな化合物からなる正孔輸送層(すなわち、正孔輸送 層B)となることが好ましい。

[0062]

[正孔輸送層を形成する化合物について]

続いて、本実施形態に係る正孔輸送層108を形成する化合物について、詳細に説明す ¹⁰る。

[0063]

本実施形態に係る正孔輸送層108では、正孔輸送層Aよりも陽極側に位置する正孔輸送層(例えば図2の場合、正孔輸送層151)を形成する化合物については、特に限定するものではなく、任意の正孔輸送材料を用いることができる。

【0064】

また、正孔輸送層A(例えば図2の場合、正孔輸送層153)を形成する正孔輸送材料 についても特に限定されるものではなく、任意の正孔輸送材料を用いることが可能であり 、正孔輸送層として形成した際に0.3MV/cm~1.0MV/cmの電界の範囲にお いて1×10⁴~1×10³cm²/V・secの正孔移動度が実現される正孔輸送 材料を用いることが好ましい。すなわち、本実施形態においては、正孔輸送層としての正 孔移動度が重要であり、ある正孔輸送材料に対してドープすることで、上記のような正孔 輸送層としての正孔移動度を実現してもよい。

【0065】

また、正孔輸送層 B を形成する正孔輸送材料についても、正孔輸送層 A を形成する正孔 輸送材料よりも相対的に小さな正孔移動度を有しているものであれば特に限定されるもの ではなく、任意の正孔輸送材料を用いることが可能であり、正孔輸送層として形成した際 に0.3 M V / c m ~ 1.0 M V / c m の電界の範囲において1×10⁻⁵ ~ 1×10⁻ ⁴ c m² / V・secの正孔移動度が実現される正孔輸送材料を用いることが好ましい。 【0066】

なお、正孔輸送層 B を形成する正孔輸送材料としては、以下に示すように、アミノカル バゾール誘導体であってもよく、モノアミン誘導体であってもよく、カルバゾール誘導体 であってもよい。

【0067】

正孔輸送層 B を形成しうるアミノカルバゾール誘導体の具体例としては、例えば、下記 一般式(1 a)又は一般式(1 b)で表される化合物を挙げることができる。 【0068】

【化4】



40

20



[0069]

ここで、上記一般式(1a)及び(1b)において、Ar₁~Ar₇は、置換もしくは 無置換のアリール基、又は、置換もしくは無置換のヘテロアリール基であり、L₁~L₂ は、結合基、置換もしくは無置換のアリーレン基、又は、置換もしくは無置換のヘテロア リーレン基である。

【0070】

また、正孔輸送層 B を形成しうるモノアミン誘導体の具体例としては、例えば、下記一 般式(2)で表される化合物を挙げることができる。

【0071】 【化5】

20

30

40

10



•••(2)

【0072】

ここで、上記一般式(2)において、R₁、R₂及びR₃は、それぞれ独立に、水素原 子、ハロゲン原子、置換もしくは無置換の炭素数1~15のアルキル基、置換もしくは無 置換の炭素数6~30のアリール基、又は、置換もしくは無置換の炭素数1~30のヘテ ロアリール基であり、1、m、nは、それぞれ0 1 4、0 m 4、0 n 5、を 満たす整数であり、Ar₁₁は、置換又は無置換の炭素数6~30のアリール基であり、 R₁₁は、水素原子、フッ素原子、置換シリル基であり、oは、0 o 3を満たす整数 である。ただし、oが2以上のとき、R₁₁は上記の中で異なっていてもよい。 【0073】

また、正孔輸送層 B を形成しうるカルバゾール誘導体の具体例としては、例えば、下記 一般式(3)で表される化合物を挙げることができる。



 $\cdot \cdot \cdot (3)$

【0075】

ここで、上記一般式(3)において、Ar₁は、炭素数6~30のアリール基、炭素数 1~30のヘテロアリール基、又は、炭素数1~15のアルキル基であり、R₁~R₁₇ は、炭素数6~30のアリール基、炭素数1~30のヘテロアリール基、炭素数1~15 のアルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子、水素原子、又は、重水素原子であり、Ar 2 は、炭素数6~30の窒素、酸素、硫黄、リン、ケイ素からなる群より選択されるヘテ ロ原子を含んでもよい縮合環、又は、炭素と窒素とからなる縮合環であり、Ar₁及びA r₂は、互いに異なる置換基であり、a及びbは、0~3であり、L₁及びL₂は、単結 合又は2価の連結基を表し、隣接した複数のR₁~R₁₀は結合し、飽和又は不飽和の環 を形成してもよい(ただし、R₁とR₆、又は、R₂とR₁₀が結合し、芳香環を形成す ることはない)。

(14)

【0076】

ここで、本明細書において、炭素数 1 ~ 1 5 のアルキル基の具体的な例としては、メチ ル(methyl)基、エチル(ethyl)基、プロピル(propyl)基、イソプ ロピル(isopropyl)基、シクロプロピル(cyclopropyl)基、ブチ ル(butyl)基、イソプチル(isobutyl)基、tert - ブチル(buty l)基、シクロブチル(cyclobutyl)基、ペンチル(pentyl)基、イソ ペンチル(isopentyl)基、ネオペンチル(neopentyl)基、シクロペ ンチル(cyclopentyl)基、ヘキシル(hexyl)基、シクロヘキシル(c yclohexyl)基、ヘプチル(heptyl)基、オクチル(octyl)基、ノ ニル(nonyl)基、デシル(decyl)基のようなC₁ - C_{1 5}の鎖状または環状 アルキル基を挙げることができる。

【0077】

また、本明細書において、炭素数1~15のアルコキシ基とは、 - O A (ただし、A は 、前述のような非置換のC₁ - C₁₅アルキル基)の化学式を有する官能基である。C₁ - C₁₅アルコキシ基の具体的な例としては、メトキシ(methoxy)基、エトキシ (ethoxy)基、プロポキシ(propoxy)基などが挙げられる。 【0078】

また、本明細書において、無置換の炭素数6~30のアリール基とは、一つ以上の芳香 族環を含むC₆-C₃₀炭素環を有する一価基を表す。前述のアリール基が、2以上の環 を含む場合、2以上の環は、互いに融合されてもよい。 【0079】

置換又は無置換のC。-C3のアリール基の具体的な例としては、フェニル(phen yl)基、ペンタレニル(pentalenyl)基、インデニル(indenyl)基 、ナフチル(naphthyl)基、アントラセニル(anthracenyl)基、ア ズレニル(azulenyl)基、ヘプタレニル(heptalenyl)基、アセナフ チレニル(acenaphthylenyl)基、フェナレニル(phenalenyl)基、フルオレニル(fluorenyl)基、アントラキノリル(anthraqui nolyl)基、フェナントリル(phenanthryl)基、ビフェニル(biph enyl)基、トリフェニレニル(triphenylenyl)基、ピレニル(pyr e n y l)基、クリセニル(chrysenyl)基、ピセニル(picenyl)基、 ペリレニル(perylenyl)基、ペンタフェニル(pentaphenyl)基、 ペンタセニル(pentacenyl)基、テトラフェニレニル(tetrapheny 1 ene)基、ヘキサフェニル(hexapheny1)基、ヘキサセニル(hexac eny1)基、ルビセニル(rubiceny1)基、トリナフチレニル(trinap h t h y l e n y l) 基、ヘプタフェニル(h e p t a p h e n y l) 基、ピラントレニ ル(pyranthrenyl)基などを挙げることができる。 [0080]

10

20



また、本明細書において、無置換の炭素数1~30のヘテロアリール基とは、N、O、 P又はSのうちから選択された1個以上のヘテロ(hetero)原子を含み、残りの環 原子がCである1以上の芳香族環を含む環を有する一価基を表す。ここで、前述のヘテロ アリール基が2以上の環を含む場合、2以上の環は互いに融合されていてもよい。 【0081】

非置換のC₁ - C₃₀ ヘテロアリール基の具体的な例としては、ピラゾリル(pyra zolyl)基、イミダゾリル(imidazolyl)基、オキサゾリル(oxazo lyl)基、チアゾリル(thiazolyl)基、トリアゾリル(triazolyl)基、テトラゾリル(tetrazolyl)基、オキサジアゾリル(oxadiazo lyl)基、ピリジニル(pyridinyl)基、ピリダジニル(pyridazin yl)基、ピリミジニル(pyrimidinyl)基、トリアジニル(triazin yl)基、カルバゾリル(carbazolyl)基、インドリル(indolyl)基 、キノリニル(quinolinyl)基、イソキノリニル基(isoquinolin yl)、ベンゾイミダゾリル(benzoimidazolyl)基、イミダゾピリジニ ル(imidazopyridinyl)基、イミダゾピリミジニル(imidazop yrimidinyl)基などを挙げることができる。

[0082]

以上のような正孔輸送材料は、市販のものを用いてもよいし、任意の合成法により合成 したものを用いてもよい。

【0083】

以上、本実施形態に係る正孔輸送層108の構成について、詳細に説明した。

【実施例】

[0084]

以下では、実施例及び比較例を示しながら、本発明の実施形態に係る有機 E L 素子について、具体的に説明する。なお、以下に示す実施例は、本発明の実施形態に係る有機 E L 素子のあくまでも一例であって、本発明の実施形態に係る有機 E L 素子が下記の例に限定 されるものではない。

[0085]

< 正孔輸送材料の合成 >

まず、以下に示す実施例で使用する正孔輸送材料を、以下のようにして合成した。 【0086】

正孔輸送材料HTM1の合成

以下の化学反応式は、正孔輸送材料 H T M 1 の合成プロセスを図示したものである。 【 0 0 8 7 】

【化7】



【0088】

[化合物 e 2 の合成]

4 - ターフェニルアミン(e1)(3.39g)、3 - ブロモ - 9 - フェニルカルバゾ ール(4.45g)、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム(0)・クロロホ ルム付加物(0.715g)、ナトリウム - t - ブトキシド(3.98g)、トリ - t -ブチルホスフィン(1.6Mキシレン溶液0.864m1)をキシレン(500mL)に 加えて脱気し、アルゴン雰囲気下、120 で12時間加熱した。反応液を冷却し、水に 投入後、トルエンで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウム

10

で乾燥し、濃縮した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィーで精製し、カルバゾリルアミン e 2 (5 . 5 8 g)を得た。

【 0 0 8 9 】

[化合物HTM1の合成]

カルバゾリルアミン e 2 (4.65g)、4-アミノ - p - ビフェニル(2.67g) 、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム(0)・クロロホルム付加物(0.4 95g)、ナトリウム - t - ブトキシド(3.98g)、トリ - t - ブチルホスフィン(1.6 M キシレン溶液 0.597mL)をキシレン(300mL)に加えて脱気し、アル ゴン雰囲気下、120 で18時間加熱した。反応液を冷却し、水に投入後、トルエンで 抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、濃縮した 。残渣をフロリジル、シリカゲルのショートカラムで精製し、化合物HTM1(4.76 g)を得た。

10

正孔輸送材料HTM2の合成

以下の化学反応式は、正孔輸送材料 H T M 2 の合成プロセスを図示したものである。 【0091】

【化8】

[0090]



【 0 0 9 2 】

[化合物 e 4 の合成]

1 - ナフチルアミン(2 . 8 2 g)、ブロモフルオロターフェニル e 3 (6 . 4 5 g) 、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム(0)・クロロホルム付加物(1 . 0 2 g)、ナトリウム - t - ブトキシド(5 . 6 9 g)、トリ - t - ブチルホスフィン(1 . 6 M キシレン溶液 1 . 2 3 m L)をキシレン(5 0 0 m L)に加えて脱気し、アルゴン 雰囲気下、1 2 0 で 1 8 時間加熱した。反応液を冷却し、水に投入後、トルエンで抽出 した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、濃縮した。残 渣をシリカゲルクロマトグラフィーで精製し、フルオロターフェニルアミン e 4 (5 . 5 3 g)を得た。

【0093】

[化合物 H T M 2 の合成]

フルオロターフェニルアミン e 4 (4.25g)、4-アミノ - p - ビフェニル(3. 06g)、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム(0)・クロロホルム付加物 (0.565g)、ナトリウム - t - ブトキシド(3.15g)、トリ - t - ブチルホス フィン(1.6Mキシレン溶液0.683mL)をキシレン(300mL)に加えて脱気 し、アルゴン雰囲気下、120 で24時間加熱した。反応液を冷却し、水に投入後、ト ルエンで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、 濃縮した。残渣をフロリジル、シリカゲルのショートカラムで精製し、化合物HTM2(3.85g)を得た。

【0094】

正孔輸送材料HTM3の合成

以下の化学反応式は、正孔輸送材料 H T M 3 の合成プロセスを図示したものである。 【 0 0 9 5 】 30



【 0 0 9 6 】

[化合物 e 5 の合成]

アルゴン雰囲気下で、1Lの四つロフラスコに3 - (4 - ブロモフェニル) - 9 - フェ ニル - 9 H - カルバゾール2 0 . 0 gを入れ、3 5 0 m L の T H F 溶媒中にて - 7 8 で 5 分攪拌した。そこへ、1 . 6 4 M の n - ブチルリチウム(n - ヘキサン溶液)3 6 . 7 m L 加え - 7 8 で1時間攪拌した。次にトリメトキシボラン1 1 . 2 m L 加え、室温で 2 時間攪拌した。その後、2 M の塩酸水溶液200m L を加え、室温で3時間攪拌した。 有機層を分取して溶媒留去した。その後、酢酸エチル / ヘキサン溶媒系で再沈殿を行い、 白色固体の化合物 e 5 を 1 5 . 6 9 g(収率 8 5 %)得た。

【 0 0 9 7 】

[化合物 e 6 の合成]

アルゴン雰囲気下で、1Lの四つロフラスコに、化合物 e 5 1 4 .0 gと3 - ブロモ カルバゾール10.4g、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(Pd(P Ph₃)₄)3.12g、炭酸カリウム(K₂CO₃)10.7g、水80mL、エタノ ール30mLを加え、400mLのトルエン溶媒中にて90 で4時間攪拌した。空冷後 、有機層を分取して溶媒留去した。その後、トルエンで再結晶を行い、白色固体の化合物 e 6を13.1g(収率70%)得た。

【0098】

「化合物HTM3の合成]

アルゴン雰囲気下、500mLの三つロフラスコに、化合物e6 9.70gと2-ブ 40 ロモフェナントレン6.76g、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム(0) (Pd₂(dba)₃)1.45g、トリ-tert-ブチルホスフィン((t-Bu) ₃P)510mg、ナトリウムtert-ブトキシド5.77gを加えて、50mLキシ レン溶媒中にて120 で12時間加熱攪拌した。空冷後、水を加えて有機層を分取し、 溶媒留去した。得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ジクロロメタ ンとヘキサンの混合溶媒を使用)で精製後、トルエン / ヘキサン混合溶媒で再結晶を行い 、白色固体の化合物HTM3を10.7g(収率75%)得た。 【0099】

なお、以下に示すHTM4及びHTM5は、Lumtec社製のものを用いた。 【0100】 20



[0101]

以下に示す実施例及び比較例では、図3に示す全体構成を有する有機EL素子200を 製造して、得られた素子性能の検討を行った。製造した有機EL素子200の概略図を、 図3に示す。

【0102】

製造した有機 E L 素子200は、陽極204、陽極204上に配置された正孔注入層2 06、正孔注入層206上に配置された正孔輸送層208、正孔輸送層208上に配置さ れた発光層210、発光層210上に配置された電子輸送層212及び電子注入層214 、電子注入層214上に配置された陰極216から構成されている。このうち、正孔輸送 層208を、下記表1に示したような物質を用いて複数層とした。 【0103】

より詳細には、本発明の実施例に係る有機EL素子の製造は、次のような手順で行った。まず、予めパターニング(patterning)して洗浄処理を施したITO-ガラス基板に、紫外線オゾン(O₃)による表面処理を行った。なお、かかるITO膜の膜厚は、150nmであった。オゾン処理後、直ちに基板を真空蒸着装置に投入し、1×10⁻⁵Pa以下で正孔注入材料として4,4',4''-トリス(N,N-(2-ナフチル)フェニルアミノ)トリフェニルアミン(2-TNATA,膜厚60nm)を上記ITO膜上に成膜した。

【0104】

次に、正孔輸送材料として、上記の化合物群(HTM1~HTM5)を用いて、全体の 厚みが80nmである正孔輸送層(Hole Transport Layer:HTL)とした。次に、発光材料として2,5,8,11-テトラ-t-プチルペリレン(TB Pe)を、9,10-ジ(2-ナフチル)アントラセン(ADN)に対して3vo1%の 割合でドープ(dope)した膜を共蒸着によって成膜した(膜厚25nm)。 【0105】

続いて、電子輸送材料としてトリス(8 - キノリノラト)アルミニウム(Alq₃)を 成膜し(膜厚25nm)、次に、電子注入材料としてフッ化リチウム(LiF)(膜厚1 .0nm)及び陰極としてアルミニウム(膜厚100nm)を順次積層した。次いで、基 板を真空蒸着装置からグローブボックスに取出し、グローブボックス内で基板とガラスを エポキシ樹脂で貼り合わせ、封止することで有機EL素子200とした。

[0106]

移動度測定

上記素子作製のようにして前処理を施した基板を蒸着装置に投入し、移動度を測定した い材料を3µm成膜し、次いで、Alを100nm成膜し電極とした。上記のようにして 封止を行った後、株式会社オプテル社製の移動度測定装置を用い、窒素レーザをITO透 明電極側から照射した時に発生した電荷のAl電極への移動速度から、移動度を求めた。 【0107】 10

20

用いた正孔輸送材料と膜厚、製造した有機EL素子200の発光効率、駆動電圧、及び、輝度半減寿命を、以下の表1にまとめて示した。製造した有機EL素子200の特性の評価には、コニカミノルタ製輝度計CS-2000及びKeithley製ソースメーター2400を用いた。下記の表1において、電流効率(cd/A)及び駆動電圧(V)は 2.5(mA/cm²)の値であり、輝度半減寿命は初期輝度1000(cd/m²)で 駆動した際の輝度が半分になる時間を測定した。なお、下記の表1においては、実施例1 で得られた発光効率、駆動電圧及び寿命を100とした相対値で結果を示している。 【0108】

(19)

【表1】

10

20

		<u>। 1</u> ग	I					
			正孔輸送層			雷流	馭動	輝度
ł			正孔輸送層	正孔輸送層	正孔輸送層	電流 効率	電圧	半減
ļ			Α	В	С			寿命
	1 2 3	1	HTM2	HTM1	_	100	100	100
		I	(72nm)	(8nm)				
		2	HTM2	HTM1		100	100	110
			(76nm)	(4nm)				
		3	HTM2	HTM1		100	100	110
			(78nm)	(2nm)				
			HTM2	HTM3		100	100	100
		4	(72nm)	(8nm)				
		ſ	HTM4	HTM1		100	90	90
	実施例	Э	(72nm)	(8nm)	_			
		6	HTM5	HTM1		100	110	90
		6	(72nm)	(8nm)	_			
		_	UTNO	HTM1:HTM4			100	100
	-	7		=8:2	_	90		
			(72mm)	(8nm)				
		8	HTM2	HTM1	HTM4	100	100	100
			(69nm)	(8nm)	(3nm)	100		
		9	HTM2	HTM1	HTM2	100	100	100
			(71nm)	(8nm)	(1nm)			
	比較例	4	HTM1	HTM2	0	80	200	50
			(72nm)	(8nm)		00	200	
		2	HTM3	HTM2	_	80	250	40
			(72nm)	(8nm)				
		3	HTM1	HTM3	_	40	500	10
			(72nm)	(8nm)				

表1 素子特性

【0109】

なお、各正孔輸送材料を用いて正孔移動度測定用サンプルを作製し測定したところ、0.7 M V / c m での正孔移動度は、H T M 1 が 6 .8 × 1 0 ⁻⁴ c m ² / V ・ s e c であ り、H T M 2 が 5 .2 × 1 0 ⁻³ c m ² / V ・ s e c であり、H T M 3 が 1 .3 × 1 0 ⁻⁵ c m ² / V ・ s e c であり、H T M 4 が 1 .1 × 1 0 ⁻³ c m ² / V ・ s e c であり、 H T M 5 が 9 .8 × 1 0 ⁻³ c m ² / V ・ s e c であった。また、正孔移動度測定用サン プルにて、正孔輸送層部分をH T M 1 とH T M 4 の比を 8 対 2 で共蒸着したサンプルの 0 .7 M V / c m での正孔移動度は、2 .0 × 1 0 ⁻⁴ c m ² / V ・ s e c であった。 【 0 1 1 0 】

上記表 2 から明らかなように、本発明の実施形態に係る実施例 1 ~実施例 9 の有機 E L 素子は、比較例 1 ~比較例 3 の有機 E L 素子に対して、高効率化及び長寿命化しているこ 30

[0 1 1 1 **]**

以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本 発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する 者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的 範囲に属するものと了解される。

【符号の説明】

10

【図1】

100



【図2】



【図3】



フロントページの続き

F ターム(参考) 3K107 AA01 BB01 CC04 CC11 CC21 DD53 DD66 DD67 DD69 DD72 DD78 FF00 FF13 FF15 4C204 AB01 BB05 CB25 EB01 FB08 GB13 GB32